



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Investiamo nel vostro futuro

**Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -**

**DICHIARAZIONE DEI REQUISITI
LOTTO 3: SISTEMA ICP-PECVD
(Inductively Coupled Plasma - Plasma Enhanced Chemical
Vapour Deposition System)**

Il presente documento riassume le specifiche dell'apparecchiatura descritte nel Capitolato Speciale - parte tecnica.

Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell'offerta tecnica, il Concorrente dovrà compilare le sottostanti tabelle.

(riferimento: Capitolato speciale parte tecnica e Relazione tecnica dell'Offerente)

Rif. requisito in Capitolato	Rispondenza	Riferimenti a paragrafi relazione tecnica	Eventuali note dell'Offerente
Caratteristiche tecniche e funzionali minime del sistema			
2.1.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.a	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.b	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.c	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.d	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.e	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.f	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2.g	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.3	<input type="checkbox"/> SI		
Caratteristiche tecniche e funzionali minime dei componenti			
Camera di processo			
2.2.1.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.4	<input type="checkbox"/> SI		
Gas box con Mass Flow Controller (MFC)			
2.2.2.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.5	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di pompaggio			
2.2.3.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.3	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di manipolazione delle fette (Load Lock & Substrate Handling System)			
2.2.4.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.5	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.6	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di controllo di apparecchiatura e processo			
2.2.5.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.2	<input type="checkbox"/> SI		

2.2.5.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.4.a	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.4.b	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.4.c	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.4.d	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.4.e	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.4.f	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.4.g	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.5	<input type="checkbox"/> SI		
Caratteristiche migliorative			
3.1a	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		
3.1b	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		
3.1c	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		
3.2	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		
3.3	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		
3.4	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		
3.5	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		

Parametri per figure di merito:

Il Concorrente deve compilare la tabella con i parametri delle ricette (# 1-4) nelle caselle evidenziate in giallo.

Tabella 1								
Film Type	Reci.	Dep Rate (DR)	Thickness	Refractive Index (RI)	Wafer Level RI Uniformity (URI)	Wafer Level Thickness Uniformity (U)	Wet Etch Rate (ER)	Breakdown Voltage
	#	nm/min	nm	#	%	%	nm/min	MV/cm
Parametro		Impostato	Impostato	Misurato	Misurato	Misurato	Misurato	Misurato
Condizioni				@ 633 nm @ T < 150 C	+/-1 sigma @ T = 150 C		BHF 10:1	
SiO ₂ low dep rate	1	15	100					
SiO high dep rate	2	30	300					
Si ₃ N ₄ low dep rate	3	15	100					
Si ₃ N ₄ high dep rate	4	30	300					

Tabella 2					
Film Type		Dep Rate (DR)	Temp.	Thickness	Stress Control
	Recipe	nm/min	C	nm	MPa
Parametro	#	Impostato	Impostato	Impostato	Misurato

SiO low dep rate	5	15	150	50	
SiO high dep rate	6	30	150	300	
SiN low dep rate	7	15	150	50	
SiN high dep rate	8	30	150	300	